

УДК 621.315.592

© 1990

НЕАДИАБАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ В ДВУХУЗЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ БИПОЛЯРОНА МАЛОГО РАДИУСА

А. Г. Петухов

Получено выражение для вероятности прыжка биполярона малого радиуса при произвольных температурах. Рассмотрение проводилось в рамках двухузельной модели в неадиабатическом режиме, когда вероятность прыжка лимитируется электронными переходами. Рассчитаны показатели экспонент и предэкспоненциальные множители для двух типов решений — туннельного (низкие температуры) и термоактивационного (высокие температуры). Результаты могут быть использованы для анализа прыжковой проводимости в материалах с биполяронным спариванием носителей заряда.

В некоторых материалах, таких как халькогенидные стеклообразные полупроводники [1], α -SiO₂ [2], WO_{3-x} [3], наблюдалась прыжковая проводимость, обусловленная перескоками биполяронов малого радиуса (БМР). Хотя такой механизм проводимости обсуждался в литературе (см., например, [1, 4]), вероятность перескока БМР между различными узлами решетки при произвольных температурах до сих пор не вычислялась.

Отметим, что в теории поляронов малого радиуса (ПМР), в частности при анализе прыжковой проводимости, аналогичная задача о вычислении вероятности прыжка ПМР занимает центральное место [5]. Такая задача рассматривалась в ряде работ [5-7], где использовалась двухузельная модель ПМР и было показано, что вероятность прыжка ПМР может быть вычислена квазиклассически подобно тому, как это делается в теории многофононных безызлучательных переходов [8, 9].

Целью данной работы является вычисление вероятности прыжка БМР в рамках двухузельной модели, сформулированной в [10]. Мы будем рассматривать только неадиабатический режим, когда ядра успевают много раз пройти через точку «встречи» термов за время, пока пара электронов резонансно протуннелирует с узла на узел (см. подробнее [6]). Количественный критерий неадиабатичности режима будет сформулирован ниже.

Рассмотрим пару узлов, каждый из которых описывается моделью Андерсона [11]. Запишем гамильтониан этой пары в виде

$$\begin{aligned}
 H_{\text{tot}} = & \frac{P^2}{2\mu} + \frac{1}{2} \mu \omega_0^2 Q^2 + \left(\frac{\Delta}{2} - \lambda Q \right) \sum_{\sigma} (n_{1\sigma} - n_{2\sigma}) + U \sum_{i=1}^2 n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} + \\
 & + C \sum_{i \neq j, \sigma, \sigma'}^2 n_{i\sigma} n_{j\sigma'} + J \sum_{i \neq j, \sigma}^2 a_{i\sigma}^+ a_{j\sigma} + H_{\text{int}} + H_{\text{ph}}. \quad (1)
 \end{aligned}$$

Здесь Q — локальная мода, отвечающая асимметричной деформации, т. е. разности локальных мод узлов [6]; P — импульс, сопряженный с координатой Q ; μ — приведенная масса ядер; ω_0 — частота локального фонона; Δ — разность одноэлектронных уровней узлов; λ — константа электрон-фононного взаимодействия (деформационный потенциал); $n_{i\sigma}$ — число заполнения одноэлектронного состояния со спином σ на узле i ;

$a_{i\sigma}^+$, $a_{i\sigma}$ — соответствующие операторы рождения и уничтожения; U — энергия кулоновского отталкивания электронов, локализованных на одном узле; C — межцентровый кулоновский интеграл; J — межцентровый интеграл электронного переноса (туннелирования); H_{int} описывает гармоническое взаимодействие моды Q с решеточными фононами (термостатом); H_{ph} — гамильтониан этих фононов.

Отметим сразу же, что учет двух последних слагаемых в гамильтониане (1) имеет принципиальное значение, поскольку именно эти слагаемые обеспечивают локализацию электронов на одном из центров и релаксационный характер межцентровых электронных переходов [7, 12-14].

Если на паре узлов локализованы два электрона ($N = \sum_{i\sigma} n_{i\sigma} = 2$), то собственными состояниями гамильтониана (1) являются три синглетных и одно триплетное состояние. Рассмотрение триплетного состояния было проведено в [10] и не представляет интереса для целей данной работы. Для исследования синглетных состояний удобно ввести операторы псевдоспина

$$\hat{S}_x = \frac{1}{2} \sum_{\sigma} (a_{1\sigma}^+ a_{2\sigma} + a_{2\sigma}^+ a_{1\sigma}), \quad \hat{S}_y = \frac{i}{2} \sum_{\sigma} (a_{1\sigma}^+ a_{2\sigma} - a_{2\sigma}^+ a_{1\sigma}),$$

$$\hat{S}_z = \frac{1}{2} \sum_{\sigma} (n_{1\sigma} - n_{2\sigma}). \quad (2)$$

Нетрудно видеть, что в пространстве трех синглетных состояний $|1\rangle = |0\rangle = a_{1\uparrow}^+ a_{1\downarrow}^+ |0\rangle$, $|2\rangle = 1/\sqrt{2} \cdot (a_{1\uparrow}^+ a_{2\downarrow}^+ - a_{2\uparrow}^+ a_{1\downarrow}^+) |0\rangle$ и $|3\rangle = a_{2\uparrow}^+ a_{2\downarrow}^+ |0\rangle$, где $|0\rangle$ — вакуумное состояние, не содержащее электронов, операторы (2) удовлетворяют соотношениям коммутации для спина $s=1$, а гамильтониан (1) преобразуется к виду¹

$$H_{\text{tot}} = H + H_{\text{int}} + H_{\text{ph}}, \quad (3)$$

где

$$H = \frac{P^2}{2\mu} + \frac{1}{2} \mu \omega_0^2 Q^2 + \left(\frac{\Delta}{2} - \lambda Q\right) \hat{S}_x + U \hat{S}_z^2 + 2J \hat{S}_x, \quad (4)$$

$\bar{U} = U - C$. Отметим, что в двухузельной модели ПМР используется аналогичный спин-бозонный гамильтониан, но для $s=1/2$ [15]. При $J=0$ гамильтониан (4) является диагональным по «спиновому» квантовому числу s_z

$$H_{s_z} = \frac{P^2}{2\mu} + \frac{1}{2} \mu \omega_0^2 \left(Q - s_z \frac{\lambda}{\mu \omega_0^2}\right)^2 - U_{\text{эфф}} (1 - s_z^2), \quad (5)$$

где $s_z = -1, 0, +1$; $U_{\text{эфф}} = \bar{U} - 2W$ — эффективная корреляционная энергия; $W = \lambda^2 / 4\mu \omega_0^2$ — поляронный сдвиг. В (5) мы для простоты ограничились рассмотрением симметричного случая $\Delta=0$ и сдвинули начало отсчета энергии к минимуму адиабатического потенциала при $s_z = -1$. На рис. 1 показаны адиабатические потенциалы, отвечающие различным значениям s_z для случая отрицательной андерсоновской корреляционной энергии $U_{\text{эфф}} < 0$. Как легко видеть, при $U_{\text{эфф}} < 0$ биполярные состояния с $s_z = \pm 1$ являются энергетически выгодными по отношению к состоянию с $s_z = 0$, отвечающему двум поляронам, локализованным на разных узлах. Прыжок биполярона соответствует изменению квантового числа s_z на ± 2 , т. е. перевороту псевдоспина.

Мы рассматриваем гамильтониан (4) с $J=0$, отвечающий бесконечно удаленным узлам, как невозмущенный. Сближение узлов приводит к росту J и, следовательно, к возникновению переходов между состояниями с различным значением псевдоспина. Наша задача состоит в вычислении темпа

¹ Конечно же, истинный спин двухэлектронной системы в синглетном состоянии равен нулю, а операторы псевдоспина имеют совершенно иной физический смысл. Так, например, \hat{S}_x является оператором дипольного момента и т. п.

(вероятности в единицу времени) перехода из состояния с $s_z = -1$ в состояние с $s_z = +1$ под действием малого возмущения $2J\hat{S}_x$ (неадиабатический режим). Как было показано в [7] (см. также [14]), понятие темпа перехода имеет смысл только при рассмотрении полного гамильтониана (3), в котором учитываются диссипативные процессы взаимодействия с решеточными фононами, приводящие к сбою фазы волновой функции и разрушению когерентных состояний. При этом выражение для темпа перехода можно записать в следующем виде [7-9]:

$$\nu_{-1, +1} = \frac{2\pi}{\hbar Z_{-1}} \sum_n \exp\left(-\frac{E_n}{T}\right) \gamma_n^2(E_n), \quad (6)$$

где Z_{-1} — статистическая сумма, отвечающая начальному состоянию с $s_z = -1$; γ_n — неадиабатический коэффициент перехода из n -го состояния

в левой яме с $s_z = -1$ в состояние n в правой яме с $s_z = +1$ (рис. 1); $\rho_{+1}(E_n)$ — плотность уровней с энергией E_n в правой яме.

В неадиабатическом режиме коэффициент γ_n определяется квадратом модуля амплитуды перехода

$$\gamma_n = |\langle \hat{\psi}_{-1, n} | \hat{T}(E_n) | \hat{\psi}_{+1, n} \rangle|^2, \quad (7)$$

где \hat{T} -матрица может быть записана в виде борновского ряда, в котором оператор $2J\hat{S}_x$ рассматривается как возмущение

$$\hat{T}(E) = 2J\hat{S}_x + 2J\hat{S}_x\hat{G}(E)2J\hat{S}_x + \dots \quad (8)$$

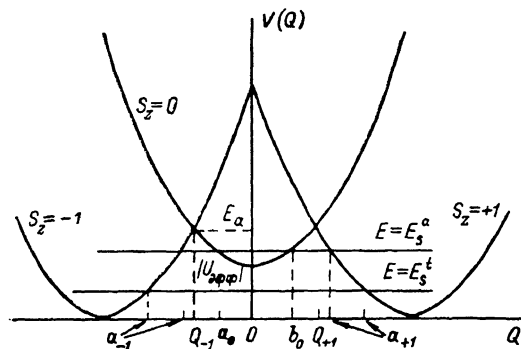


Рис. 1. Адиабатические потенциалы двухузельной модели БМР для $J=0$, $U_{эфф} < 0$.

Горизонтальными линиями показаны оптимальные энергии, отвечающие прыжку БМР.

Здесь $\hat{G}(E)$ — матричная функция Грина невозмущенного гамильтониана (4) с $\Delta = J=0$

$$\hat{G}(E) = G_0\hat{I} + (G_+ - G_0)\hat{S}_z^2 + G_-\hat{S}_z, \quad (9)$$

где \hat{I} — единичный оператор, а

$$G_0 = (E - H_0)^{-1}, \quad G_{\pm} = \frac{1}{2} [(E - H_{-1})^{-1} \pm (E - H_{+1})^{-1}]. \quad (10a), 10б$$

Различные H_{s_z} даются формулой (5), а волновые функции $\hat{\psi}_{-1}$ и $\hat{\psi}_{+1}$ имеют вид

$$\hat{\psi}_{-1, n} = \varphi_{-1, n}(Q) \hat{\chi}_{-1}, \quad \hat{\psi}_{+1, n} = \varphi_{+1, n}(Q) \hat{\chi}_{+1}, \quad (11)$$

где $\hat{\chi}_{\pm 1}$ — собственные векторы оператора \hat{S}_z , отвечающие собственным значениям $s_z = \pm 1$; $\varphi_{\pm 1, n}$ — собственные функции операторов $H_{\pm 1}$ (5). Подставляя (8)–(11) в (7), можно получить выражение для амплитуды перехода. Нетрудно видеть, что вклад первого порядка в амплитуду перехода обращается в нуль, а во втором порядке по J получим

$$\langle \hat{\psi}_{-1, n} | \hat{T}(E_n) | \hat{\psi}_{+1, n} \rangle = 4J^2 \langle \hat{\chi}_{-1} | \hat{S}_z^2 | \hat{\chi}_{+1} \rangle \int \varphi_{-1, n}^*(Q) G_0(Q, Q', E_n) \times \\ \times \varphi_{+1, n}(Q') dQdQ', \quad (12)$$

где $G_0(Q, Q', E)$ — функция Грина (10a) в координатном представлении.

Интеграл в (12) удобнее всего вычислять в квазиклассическом приближении, используя метод комплексных траекторий Ландау [16, 17]. Запишем асимптотическое выражение для пропагатора $G_0(Q, Q', E)$ в приближении стационарной фазы [18, 19]

$$G_0(Q, Q', E) = \frac{\mu}{\hbar^2} [k_0(Q, E) k_0(Q', E)]^{-1/2} \exp(-2S_0(E)). \quad (13)$$

Здесь

$$k_0(Q, E) = \hbar^{-1} [2\mu(V_0(Q) - E)]^{1/2} = \hbar^{-1} \left[2\mu \left(\frac{1}{2} \mu \omega_0^2 Q^2 + U_{\text{эфф}} - E \right) \right]^{1/2},$$

$$S_0(E) = \begin{cases} \frac{1}{\hbar} \int_Q^{Q'} k_0(Q'', E) dQ'', & E < U_{\text{эфф}}, \\ \frac{1}{\hbar} \left[\int_Q^{a_0} k_0(Q'', E) dQ'' + \int_{b_0}^{Q'} k_0(Q'', E) dQ'' \right], & E > U_{\text{эфф}}, \end{cases} \quad (14)$$

a_0, b_0 — классические точки поворота для потенциала $V_0(Q)$. В формуле (13) опущены сингулярные члены, отвечающие многократному отражению от стенок потенциальной ямы в классически разрешенной области, поскольку в соответствии с выводами работы [7] не следует учитывать когерентные процессы.

При интегрировании по Q и Q' в (12) смещаем контур интегрирования в комплексную плоскость, что дает возможность использовать для квазиклассических функций $\varphi_{-1}(Q)$ и $\varphi_{+1}(Q)$ их асимптотические выражения вдали от классических точек поворота a_{-1} и a_{+1} (рис. 1). Вычисляя интеграл методом перевала, получим

$$\gamma(E) = \frac{4\omega_0^4 \mu^2 J^4 \exp[-2\Psi(E)]}{(\hbar\omega_0)^2 |F_{-1} F_{+1}| k_{-1}(Q_{-1}) k_{+1}(Q_{+1})}, \quad (15)$$

где

$$k_{\pm 1}(Q) = \hbar^{-1} [2\mu(V_{\pm 1}(Q) - E)]^{1/2} = \hbar^{-1} \left[\frac{1}{2} \mu \omega_0^2 \left(Q \pm \frac{\lambda}{\mu \omega_0^2} \right)^2 - E \right]^{1/2},$$

$Q_{\pm 1}$ — точки пересечения термов (рис. 1),

$$F_{\pm 1} = \frac{d}{dQ} [V_{\pm 1}(Q) - V_0(Q)] |_{Q=Q_{\pm 1}}, \quad (16)$$

$\Psi(E)$ дается выражением

$$\Psi(E) = \text{Re} \left\{ \int_{a_{-1}}^{Q_{-1}} k_{-1}(Q, E) dQ + \int_{Q_{-1}}^{Q_{+1}} k_0(Q, E) dQ + \int_{Q_{+1}}^{a_{+1}} k_{+1}(Q, E) dQ \right\} \frac{1}{\hbar}. \quad (17)$$

Непосредственное вычисление по формуле (17) дает

$$\Psi(E) = \frac{2W}{\hbar\omega_0} \left[\sqrt{(1+u^2) - 4\varepsilon} + 2(u - \varepsilon) \ln \frac{1 - u + \sqrt{(1+u)^2 - 4\varepsilon}}{2\sqrt{|\varepsilon - u|}} - 2\varepsilon \ln \frac{1 + u + \sqrt{(1+u)^2 - 4\varepsilon}}{2\sqrt{\varepsilon}} \right], \quad (18)$$

где $\varepsilon = E/2W$, $u = 1 - \bar{U}/2W > 0$, поскольку мы рассматриваем случай $U_{\text{эфф}} < 0$. Вычислим также

$$\tau(E) = -\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial E} = \begin{cases} \frac{2}{\omega_0} \text{Arsh} \frac{1+u-2\varepsilon}{2\sqrt{\varepsilon}(u-\varepsilon)}, & \varepsilon < u, \\ \frac{2}{\omega_0} \text{Arch} \frac{1+u-2\varepsilon}{2\sqrt{\varepsilon}(\varepsilon-u)}, & \varepsilon > u. \end{cases} \quad (19)$$

Теперь можно перейти к расчету темпа перехода. Для достаточно высоких температур суммирование в (6) заменяем интегрированием

$$\nu_{-1, +1} = \frac{2\pi}{\hbar^3 \omega_0^3 Z_{-1}} \int \exp\left(-\frac{E}{T}\right) \gamma(E) dE. \quad (20)$$

Подставляя (15) в (20) и интегрируя по E методом перевала, получим

$$\nu_{-1, +1} = \frac{J^4 \pi}{\hbar Z_{-1} (\hbar \omega_0)^2 W (E_a - E_s)} \left(\frac{2\pi}{\Phi''(E_s)} \right)^{1/2} \exp[-S(T)], \quad (21)$$

где $E_a = W/2 \cdot (1+u)^2$ — энергия активации, отвечающая точкам пересечения термов $Q_{\pm 1}$, $Z_{-1} = (2 \operatorname{sh}(\hbar \omega_0/2T))^{-1}$, $S(T) = \Phi(E_s)$,

$$\Phi(E) = E/T + 2\Psi(E), \quad (22)$$

а E_s определяется из уравнения

$$\left. \frac{d\Phi}{dE} \right|_{E=E_s} = \frac{1}{T} - \frac{2}{\hbar} \tau(E_s) = 0. \quad (23)$$

Уравнение (23) имеет два решения, минимизирующих действие $\Phi(E)$. При низких температурах реализуется решение туннельного типа с $E_s = E_s^t < 2W - \bar{U}$, а при высоких — «термоактивационного» типа с $E_s = E_s^a > 2W - \bar{U}$

$$E_s^t = W [u + \operatorname{ch}^{-2} \xi_s - \operatorname{th} \xi_s (u^2 - \operatorname{ch}^{-2} \xi_s)^{1/2}], \quad (24)$$

$$E_s^a = W [u - \operatorname{sh}^{-2} \xi_s + \operatorname{cth} \xi_s (u^2 + \operatorname{sh}^{-2} \xi_s)^{1/2}], \quad (25)$$

где $\xi_s = (\omega_0/2) \tau_s = \hbar \omega_0/4T$. Соответствующие значения $S(T)$ даются выражениями

$$S_t(T) = (4W/\hbar \omega_0) [u \xi_s + \operatorname{th} \xi_s - u \operatorname{Arch}(u \operatorname{ch} \xi_s) + (u^2 - \operatorname{ch}^{-2} \xi_s)^{1/2}], \quad (26)$$

$$S_a(T) = (4W/\hbar \omega_0) [u \xi_s + \operatorname{cth} \xi_s + u \operatorname{Arsh}(u \operatorname{sh} \xi_s) - (u^2 + \operatorname{sh}^{-2} \xi_s)^{1/2}]. \quad (27)$$

Формулы (21)–(27) позволяют вычислить темп перехода при произвольных температурах.

На рис. 2 показана температурная зависимость действия $S(T)$ для различных решений уравнения (23). При низких температурах абсолютному минимуму действия отвечает туннельное решение с $S = S_t(T)$, которое существует только при $T < T_1 = \hbar \omega_0 (4 \operatorname{Arch}(1/u))^{-1}$, а при высоких температурах конкуренцию выигрывает термоактивационное² решение с $S = S_a(T) \simeq (W/2T) (1+u)^2$. Температуру перехода T_a от туннельного режима к активационному можно грубо оценить, приравняв предельные значения $S_a(T)$ и $S_t(0) = (4W/\hbar \omega_0)(1+u-u \ln u)$

$$T_a \simeq (\hbar \omega_0/4) (1+u)^2 / (1+u-u \ln u). \quad (28)$$

При высоких температурах ($\xi_s = \hbar \omega_0/4T \ll 1$, $T \gg T_a$) температурная зависимость вероятности прыжка становится чисто активационной

$$\nu_{-1, +1} = \frac{\omega_0}{2\pi} \frac{16\pi^{5/2} (1+u)^2 J^4}{(\hbar \omega_0)^3 E_a (1-u)} \left(\frac{T}{E_a} \right)^{1/2} \exp\left(-\frac{E_a}{T}\right). \quad (29)$$

При достаточно больших значениях интеграла туннелирования J теория возмущений по этому параметру неприменима и для вычисления темпа перехода необходимо воспользоваться адиабатической теорией^[5, 6, 8, 9]. Можно показать, что в адиабатическом режиме аналог формулы (21) при достаточно низких температурах имеет вид^[6, 9]

$$\nu_{-1, +1}^{\text{ад}} = \frac{1}{2\pi \hbar Z_{-1}} \left(\frac{2\pi}{\Phi''(E_s)} \right)^{1/2} \exp(-S(T)). \quad (30)$$

Сравнивая (30) и (21), получим критерий неадиабатичности режима

$$\eta = 2\pi^2 J^4 / (\hbar \omega_0)^2 W E_a \ll 1, \quad (31)$$

где η — так называемый параметр неадиабатичности^[5, 6]. Критерий (31) справедлив при достаточно низких температурах, когда прыжки биполяр-

² Решение с $S = S_a(T)$ мы называем термоактивационным условно, имея в виду, что соответствующая ему «энергия активации» $E_a(T) = T S_a(T)$ хотя и зависит от температуры, но лежит в узком интервале $|U_{\text{эфф}}| < E_a(T) < (W/2)(1+u)^2$.

рона осуществляются туннельным образом. Для того чтобы сформулировать критерий неадиабатичности при произвольных температурах, необходимо более детально исследовать адиабатический режим прыжков и процесс диссоциации БМР. Такое рассмотрение, однако, выходит за рамки данной работы.

Отметим, что в частном случае $u=0$ (нулевая эффективная корреляционная энергия) имеется только решение с $S=S_a(T)$, а формула (21) с точностью до множителя 4 совпадает с результатом Холстейна [20] для случая сильной дисперсии решеточных фононов, полученным для ПМР в четвертом порядке по J . Это неудивительно, поскольку при $u=0$ прыжок биполярона осуществляется за счет двух последовательных перескоков ПМР. Наличие множителя 4 связано с тождественностью частиц и неразличимостью процессов перехода электронов с различным направлением спина.

Интересно также сравнить полученные результаты с результатами работ [21, 22], где рассматривались термоактивационные прыжки БМР в рамках метода эффективного биполяронного гамильтониана. Отметим, что в пределе сильной связи, когда $u \leq 1$ и глубина центральной ямы $\delta = E_a - |U_{\text{эфф}}|$ (рис. 1) близка к энергии локального фонона $\hbar\omega_0$, выражение для предэкспоненциального множителя в формуле (29) не является корректным

ввиду неприменимости квазиклассического подхода к описанию состояний с $S_z=0$ и энергией в интервале $|U_{\text{эфф}}| < E < E_a$. В этом случае, однако, туннельное решение существует вплоть до высоких температур $T < T_1$ (рис. 1) и в области $\hbar\omega_0/4 < T < T_1$ температурная зависимость $S_z(T)$ плавно переходит в активационную. Нетрудно видеть, что в этой области при $\delta \ll E_a$

$$E_s^i = E_a (1 - \zeta_s^2 + O(\delta/E_a)). \quad (32)$$

Подставляя (32) в (21), получим

$$\nu_{-1, +1} = \frac{8J^4 \pi^{3/2}}{\hbar (\hbar\omega_0)^2 W} \left(\frac{T}{E_a}\right)^{1/2} \exp\left(-\frac{E_a}{T}\right). \quad (33)$$

Если теперь провести замену обозначений, соответствующую обозначениям работы [22], а именно энергию активации прыжка ПМР $W/2$ заменить на E_a , энергию связи БМР $|U_{\text{эфф}}| = 2W - U \rightarrow U$ и соответственно $u \rightarrow U/4E_a$, а $E_a = (W/2)(1+u)^2 \rightarrow (U+4E_a)^2/16E_a$, то, как нетрудно видеть, формула (33) в точности совпадает с формулой (41) из работы [22].

Отметим, что по смыслу туннельное решение с $S=S_z(T)$ отвечает прыжку биполярона как целого, в то время как активационное решение соответствует двум последовательным прыжкам ПМР. Важно подчеркнуть, что в случае $u < 1$, когда нельзя пренебречь энергией кулоновского отталкивания электронов U , прыжок БМР как целого при температурах $T < T_1$ невозможен.

В заключение обсудим кратко экспериментальные данные, полученные в работе [3]. В [3] было показано, что в нестехиометрическом кристаллическом WO_{3-x} имеет место диамагнитное спаривание ПМР, приводящее к образованию автолокализованных БМР. Были найдены энергии оптической ионизации БМР $E_b^{\text{opt}} = 1.1$ эВ и ПМР $E_p^{\text{opt}} = 0.71$ эВ, а также энергия

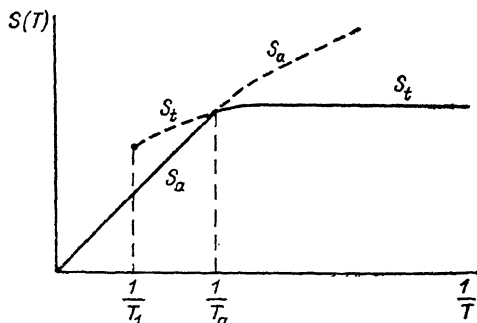


Рис. 2. Температурная зависимость оптимального действия, отвечающего прыжку БМР, $T_1 = \hbar\omega_0 (4 \text{Arch}(1/u))^{-1}$.

Величины $S_z(T)$, $S_a(T)$ и T_a даются формулами (26)–(28).

активации темновой проводимости $E_a = 0.16$ эВ, отвечающей перескокам БМР. Проводимость измерялась в довольно узком интервале температур $\sim 90 \div 130$ К. С помощью элементарных вычислений легко показать [23], что $E_p^{\text{opt}} - E_b^{\text{opt}} = U_{\text{эфф}} = U - 2W$. Таким образом, для WO_{3-x} величина $U_{\text{эфф}}$ составляет -0.4 эВ. В то же время энергия активации темновой проводимости E_a существенно меньше $|U_{\text{эфф}}|$, хотя из вышеприведенной теории (см. формулы (21), (29)), следует, что эта энергия $E_a = (W/2)(1+u)^2 > |U_{\text{эфф}}|$. Указанное противоречие, по всей вероятности, связано с тем, что измеренная проводимость либо отвечает области температур, близких к температуре перехода от туннельных прыжков к активационным, где температурная зависимость темпа перехода не является экспоненциальной, либо соответствует адиабатическому режиму. В последнем случае происходит сильная редукция конфигурационного барьера за счет квантовомеханического расщепления термов [10].

Дальнейшее сравнение теории с экспериментом можно проводить, анализируя проводимость на переменном токе [24]. Такой анализ, однако, требует отдельного рассмотрения.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Elliot S. R. // *Phil. Mag.* 1977. V. B36. N 9. P. 1291—1299.
- [2] Meaudre M., Meaudre R. // *Phys. Rev.* 1984. V. B29. N 12. P. 7014—7019.
- [3] Shirmer O. F., Salje E. // *J. Phys.* 1980. V. C13. P. L1067—L1071.
- [4] Long A. R. // *Adv. Phys.* 1982. V. 31. N 5. P. 553—637.
- [5] Сб. «Поляроны» / Под ред. Ю. А. Фирсова. М.: Наука, 1975. 424 с.
- [6] Holstein T. // *Phil. Mag.* 1978. V. B37. N 1. P. 49—62.
- [7] Holstein T. // *Phil. Mag.* 1978. V. B37. N 4. P. 499—526.
- [8] Englman R. // *Sol. St. Comm.* 1983. V. 47. N 9. P. 723—726.
- [9] Мешков С. В. // *ЖЭТФ*. 1985. Т. 89. № 11. С. 1734—1745.
- [10] Петухов А. Г. // *ФТП*. 1988. Т. 22. № 3. С. 527—529.
- [11] Anderson P. W. // *Phys. Rev. Lett.* 1975. V. 34. N 15. P. 953—955.
- [12] Langer J. S. // *Ann. Phys. (N. Y.)*. 1969. V. 54. P. 258—275.
- [13] Caldeira A. O., Leggett A. J. // *Ann. Phys. (N. Y.)*. 1983. V. 149. P. 374—456.
- [14] Ларкин А. И., Овчинников Ю. Н. // *ЖЭТФ*. 1984. Т. 86. № 2. С. 719—726.
- [15] Feinberg D., Ranninger J. // *Physica*. 1984. V. D14. P. 29—48.
- [16] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. *Квантовая механика*. М.: Наука, 1975. 752 с.
- [17] Гельмонт Б. Л., Перель В. И., Ясневич И. Н. // *ФТТ*. 1983. Т. 25. № 3. С. 727—733.
- [18] McLaughlin D. W. // *J. Math. Phys.* 1972. V. 13. N 8. P. 1099—1108.
- [19] Holstein B. R., Swift A. R. // *Am. J. Phys.* 1982. V. 50. N 9. P. 829—839.
- [20] Holstein T. // *Ann. Phys. (N. Y.)*. 1981. V. 132. P. 212—234.
- [21] Брыксин В. В., Волошин В. С. // *ФТТ*. 1984. Т. 26. № 8. С. 2357—2364.
- [22] Брыксин В. В., Гольцев А. В. // *ФТТ*. 1988. Т. 30. № 5. С. 1476—1486.
- [23] Балагуров Л. А., Омеляновский Э. М., Петухов А. Г., Стариков М. Н., Фойгель М. Г. // *ФТП*. 1987. Т. 21. № 9. С. 1631—1636.
- [24] Петухов А. Г., Фойгель М. Г. // *ЖЭТФ*. 1989. Т. 95. № 3. С. 1037—1048.

Одесский государственный университет
им. И. И. Мечникова
Одесса

Поступило в Редакцию
31 марта 1989 г.
В окончательной редакции
11 июля 1989 г.